



B772P

PNP

主要用途:

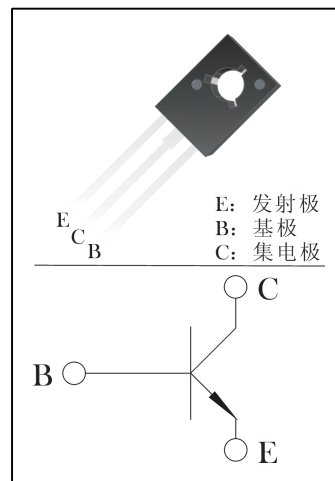
高频放大电路、应急灯、电动玩具控制电路。

主要特点:

硅外延平面工艺、输出特性好、电流容量大。

封装形式:

T0-126



极限值 (TC=25℃)

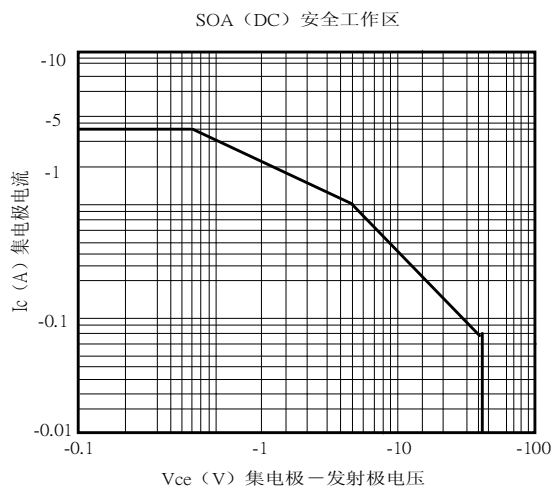
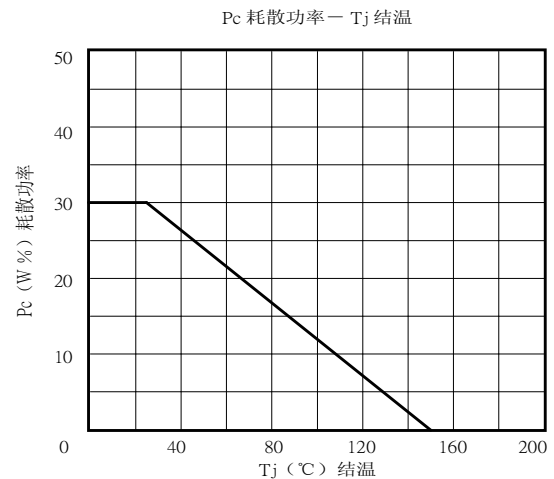
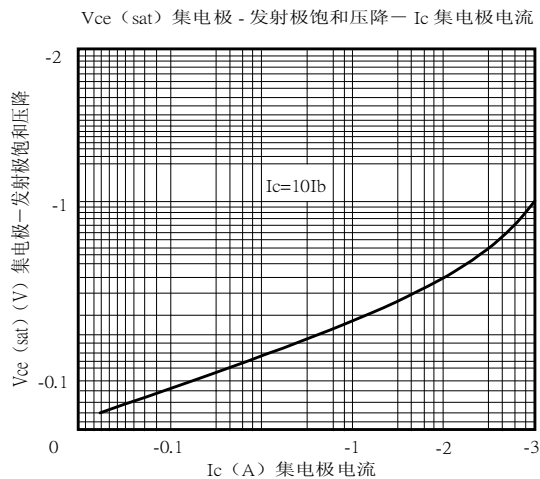
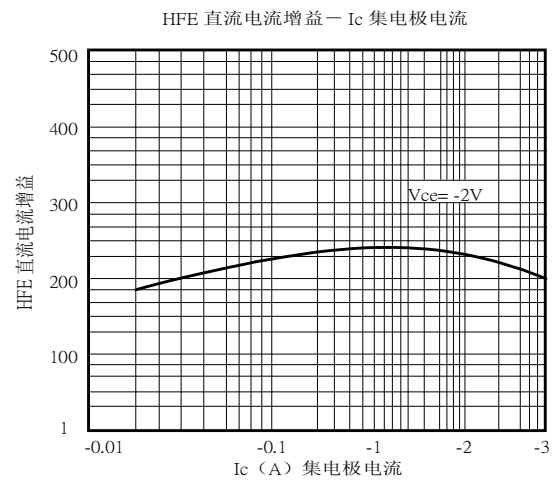
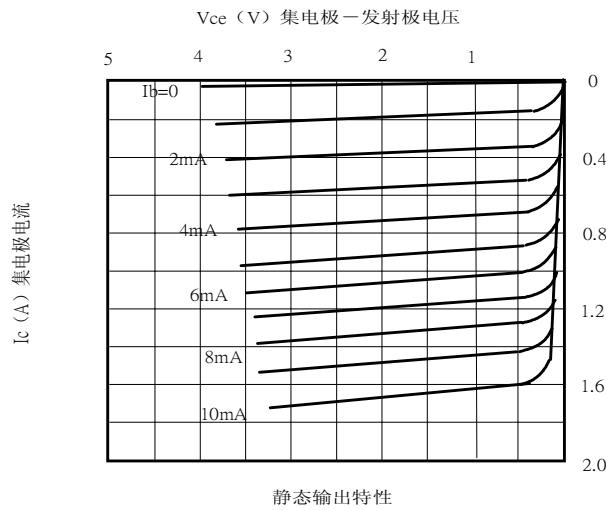
参数名称	符号	额定值	单位
集电极-发射极击穿电压	BVce0	≥ -40	V
集电极-基极击穿电压	BVcb0	≥ -30	V
发射极-基极击穿电压	BVeb0	≥ -6	V
最大集电极直流电流	Icm	-3	A
最大耗散功率	Pcm	-35	W
最高工作温度	Tj	150	℃
贮存温度	Tstg	-55~150	℃

电特性 (TC=25℃)

参数名称	符号	测试条件	额定值		单位
			最小值	最大值	
集电极-发射极击穿电压	BVce0	Ic=-1mA IB=0	-30		V
集电极-基极击穿电压	BVcb0	Ic=-1mA IE=0	-40		V
发射极-基极击穿电压	BVeb0	IE=-1mA IC=0	-6		V
集电极-发射极反向漏电流	Ice0	Vce=-30V IB=0		-20	uA
集电极-发射极反向漏电流	Icb0	Vcb=-40V IE=0		-10	uA
发射极-基极反向漏电流	Ieb0	Veb=-6V IC=0		-10	uA
共发射极直流电流增益	Hfe	Vce=-2V IC=-1A	100	300	
集电极-发射极饱和压降	Vcesat	Ic=-2A Ib=-0.2A		-0.6	
特征频率	fT	Vce=-5V Ic=-0.1A f=10MHz	50		MHZ



特性曲线





产品尺寸

TO-126

